
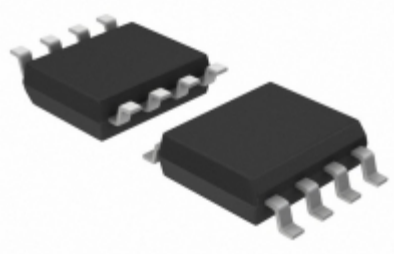








	<h2 style="color: #E67E22;">NTMS4177PR2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMS4177PR2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 6.6A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  NTMS4177PR2G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 143780 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMS4177PR2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 6.6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	143780 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	840mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 11.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 24V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTMS4177PR2G ist neu im Original, Suche NTMS4177PR2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMS4177PR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMS4177PR2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTMS4503NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 28V 9A 8-SOIC</p>	 <p>NTMS4404NR2G ON NTMS4404NR2G ON</p>	 <p>NTMS4177PE2G ON NTMS4177PE2G ON</p>	 <p>NTMS4118NR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS4118NR2 ON</p>
 <p>NTMS4404NR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7A 8-SOIC</p>	 <p>NTMS4107NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p>NTMS4503NSR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 28V 14A 8SO</p>	 <p>NTMS4503NR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 28V 9A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

NTMFS4C08NT1G	NTMFS4C09NAT1G	NTMFS4C09NT1G	NTMFS4C10NT1G	NTMFS4C13NT1G
NTMFS4C35N	NTMFS4C55NT1G	NTMFS4C58NT1G	NTMFS4C800NT1G	NTMFS5844NLT1G
NTMFS5C404NLT1G	NTMFS5C612NLT1G	NTMFS5C628NLT1G	NTMFS5C646NLT1G	NTMFS5C670NLT1G
NTMS10P02	NTMS10P02R2	NTMS10P02R2G	NTMS3P03R2	NTMS3P03R2G
NTMS4101PR2G	NTMS4105NR2G	NTMS4107NR2G	NTMS4176PR2G	NTMS4177P
NTMS4404NR2G	NTMS4503NR2G	NTMS4700NR	NTMS4700NR2G	NTMS4704NR2G
NTMS4705NR2G	NTMS4706NR2G	NTMS4800NR2G	NTMS4801N	NTMS4801NR2G
NTMS4802N	NTMS4802NR2G	NTMS4807N	NTMS4807NR2G	NTMS4816N
NTMS4816NG	NTMS4816NR2G	NTMS4840NR2G	NTMS4872NR2G	NTMS4873NFR2G
NTMS4916AS001	NTMS4916N	NTMS4916NR2G	NTMS4916UT001	NTMS4917NR2G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited